

У блоці 2 відбувається порівняння сигналу розузгодження штучної нейтралі з опорним сигналом, який формується блоком 7, і на основі цього формувачем Ф створюється вихідний імпульс, який у разі виникнення аварійного режиму роботи двигуна зумовить спрацювання потужних ключів і реле захисту Р блока 3, яке, свою чергою, відімкне ЕД від мережі. У цей момент у блоці 6 відбувається індикація спрацювання системи захисту та індикація місця виникнення аварії. Так, при обриві однієї або двох фаз живлення відбувається індикація фази, в якій сталося пошкодження. Якщо ж з'явилася вібрація вала ротора, то відбувається індикація зміни частоти обертання вала, а при погіршенні ізоляції обмоток здійснюється індикація значення напруги в службовій нейтралі ЕД.

Блок електронних фільтрів 5 з давачем вібрації М (конденсаторним чи п'езокерамічним) слідкує за частотою обертання вала ротора двигуна. Смугові фільтри блока 5 налаштовуються на частоту другої гармоніки, яка сигналізує про биття вала, зумовлене його викривленням або виходом з ладу підшипників, що може привести до аварії ЕД. Блок 5 з'єднаний з формувачем блока 2 і має можливість незалежно від блоків 1 і 2 здійснювати спрацювання системи захисту.

Якщо, наприклад, зникне напруга мережі в фазі, яка живить систему захисту, то це призведе до обезструмлення всіх блоків системи. Реле Р блока 3, у цьому випадку розімкне контакти живлення котушки теплового реле ЕД і він буде відімкнений від мережі. Індикатори блока 6 вкажуть на аварію і покажуть фазу, в якій вона відбулась. Індикація відбуватиметься і при вимкненному джерелі живлення 7 внаслідок використання в системі захисту малогабаритних акумуляторів.

Систему захисту в процесі роботи ЕД можна застосовувати і для його діагностики. Діагностику можна проводити за показами індикатора напруги в службовій нейтралі, яка характеризує якість ізоляції та симетричність режимів роботи двигуна за напругами на резисторах R2, R4, R5, які свідчать про якість живлення ЕД.

Система апробована в умовах вузла навантаження централізованої теплової мережі впродовж 1996-1998 рр.

1. Когородский В.И. Релейная защита электродвигателей. М., 1987. 2. Справочное пособие по электротехнике и основам электроники / П.В.Ермуратский, А.А.Косякин, В.С.Листвин и др.; Под ред. А.В.Нетушиной. М., 1986.

УДК 548.732

ВИЗНАЧЕННЯ ПРУЖНИХ ДЕФОРМАЦІЙ У КРИСТАЛІЧНИХ ПЛАСТИНАХ

© Криштаб Т.Г., Литвин О.С., Литвин П.М., Прокопенко І.В., 1998

Інститут фізики напівпровідників НАН України, м. Київ

Запропонований метод контролю пружніх деформацій в монокристалічних пластинах, який базується на рентгенодифрактометричних вимірюваннях радіуса кривизни атомних площин поверхні. Метод дає змогу підвищити експресність та локальність діагностики.

При виробництві напівпровідникових електронних приладів визначальний вплив на їх електрофізичні та експлуатаційні характеристики має рівень структурної досконалості вихідних монокристалічних пластин. Присутні в монокристалі одно-, дво- та тривимірні дефекти кристалічної матриці складно відображаються в загальному розподілі полів пружних деформацій, які свою чергою впливають на процеси зародження, міграції та анігіляції структурних дефектів. Тому контролю рівня пружних деформацій у монокристалічних пластинах на всіх ділянках технологічного циклу повинна приділятись особлива увага. Серед існуючих методів, які дають змогу прямо чи

опосередковано вимірювати пружні деформації в монокристалічних об'єктах, найширшого застосування набули неруйнівні рентгенодифрактометричні методи. Свою чергою серед останніх найуніверсальнішим, щодо застосуваності до різних матеріалів є метод вимірювання кривизни атомних площин. Цей метод існує в різних модифікаціях, однак, жодна з них не позбавлена недоліків. Так, метод трансляції зразка [1] вимагає виготовлення спеціальних прецизійно-транслюючих гоніометричних головок, а також обмежений мінімальним розміром зразків; застосування методів трикристальні дифрактометрії [2, 3] обмежується складною рентгенооптичною геометрією, неоднозначністю

інтерпретації форми кривої дифракційного відбивання (КДВ) та наявністю верхньої і нижньої меж вимірювань; у методах двокристальні [4, 5] дифрактометрії з використанням спектрального складу випромінювання виникають труднощі із розподіленням на КДВ піків K_{α} дублета, а при застосуванні β -лінії - із реєстрацією випромінювання, розподіленого в такому значному кутовому діапазоні. Автори пропонують метод вимірювання

кривизни приповерхневих атомних площин, який займає проміжне місце між дво- та трикристальними дифрактометричними методами.

Для збільшення розподільчої здатності методу в схемі дифрактометра автори використали блок monoхроматора, вирізаний з досконалого монокристала кремнію з орієнтацією відбиваючих поверхонь (111). Схема методу показана на рисунку.

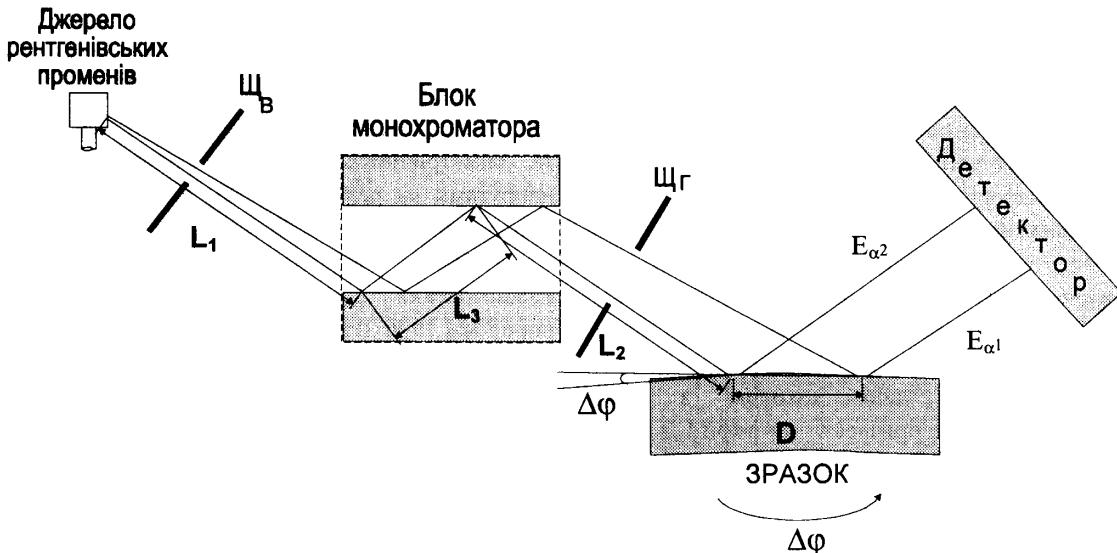


Схема методу вимірювання радіуса кривизни на двокристальному спектрометрі з блоком monoхроматора:
Щ_В - вертикальна щілина, Щ_Г - горизонтальна.

Двократна монохроматизація падаючого випромінювання (відбиття (333)) дала змогу отримати $CuK_{\alpha 1}$ та $CuK_{\alpha 2}$ лінії із спектральною шириною $\frac{\Delta\lambda}{\lambda} \sim 10^{-5}$. Як поворотно-вимірювальний пристрій у схемі установки використаний оптичний гоніометр ГС-5, який дає можливість вимірювати кути повороту з точністю до $0,5''$, що своєю чергою зняло необхідність точного вимірювання КДВ. Відстань L від фокуса рентгенівської трубки до центра гоніометра вибрана так, щоб відстань D між точками падіння променів $K_{\alpha 1}$ та $K_{\alpha 2}$ на досліджувальний зразок була якомога більшою, але в той же час, усувала можливість розходження променів $K_{\alpha 1,2}$ на значення більше, ніж розміри вікна лічильника, а також не перевищувала мінімальний розмір зразків. Вимірювання проводяться як у бездисперсійній ($n-n$), так і дисперсійній ($n-m$) схемах дифракції. Так, наприклад, при вимірюванні радіуса кривизни кремнієвих пластин на відбитті (333), схема ($n-n$) стане дисперсійною винятково за рахунок згину

зразка і значення кута $\Delta\phi$ між положеннями зразка, в яких детектор реєструє максимуми відбивань від дублета $K_{\alpha 1,2}$, однозначно визначатиме знак та радіус кривизни R

$$R = \frac{D}{\Delta\phi}, D = L(\theta_{m2} - \theta_{m1}) = L \frac{\Delta\lambda}{\lambda_{av}} \operatorname{tg} \theta_m,$$

$$L = L_1 + L_2 + L_3, \quad (1)$$

де $\theta_{m2} - \theta_{m1} = \Delta\theta_m$ - розбіжність променів K_{α} дублета після монохроматора; $\Delta\lambda$ - різниця довжин хвиль K_{α} дублета; λ_{av} - середня довжина хвилі K_{α} дублета; θ_m - брегівський кут для монохроматора.

При дослідженнях зразків у схемі ($n-m$) потрібно врахувати початкову дисперсійність схеми. Формула (1) у загальному випадку набуває вигляду

$$R = \frac{D}{\sin \theta_{cr} \Delta\phi'}, \quad \Delta\phi' = \Delta\theta_m - \Delta\theta_{cr} - \Delta\phi, \quad (2)$$

де θ_{cr} - кут брегівського відбиття для зразка; $\Delta\theta_{cr}$ - розбіжність променів K_{α} дублета після зразка.

В реалізованій нами геометрії установки чутливість методу становить $1,5 \cdot 10^{-3}$ м, а мінімальний розмір зразка – 3 мм. Потрібно зауважити, що дослідження зразків, кривизна яких настільки мала, що піки дублета не розділяються, потрібно проводити в дисперсійній схемі з використанням асиметричних відбиттів.

Значення пружної деформації ε у наближенні, що товщина кристала t значно менша від R та максимальне відхилення поверхні кристала від горизонтального рівня значно менше ніж t , задається досить простим співвідношенням

$$\varepsilon = \frac{t}{2R}. \quad (3)$$

Порівняння даних вимірювання радіуса кривизни монокристалічної пластини запропонованім методом та класичним методом трансляції зразка дає збіжність не гірше $\pm 10\%$.

Отже, запропонований метод визначення радіуса кривизни є експресним, не потребує точного вимірювання КДВ і його можна використовувати

для зразків малих розмірів або для визначення пружних напруг у локальних областях по пластині.

1. Godvod K., Nagy A.T., Rek Z. *The Application of the X-Ray Triple-Crystal-Spectrometer for Measuring the Radius Curvature of Bend Single Crystals* // *Phys. Stat. Sol. (A)*. 1976. Vol. 34. N 2. P. 705-710. 2. Мальцев Ю.Ф., Гаркушев Е.Н., Никифоров И.Я. *Новый метод измерения кривизны кристаллов на трехкристальном рентгеновском дифрактометре* // *Кристаллография*. 1998. Т. 43. № 2. С. 360. 3. Завьялова А.А., Ломов А.А., Маргушев З.Ч. *Трехкристальная рентгеновская дифрактометрия в исследовании изогнутых монокристаллов* // *Кристаллография*. 1991. Т. 36. № 1. С. 20-24. 4. Cohen B.G., Focht M.W. *X-ray Measurement of Elastic Strain and Annealing in Semiconductors* // *Solid-State Electronics*. 1970. Vol. 13. P. 105-112. 5. Носков А.Г., Труханов Е.М. *Повышение чувствительности метода измерения кривизны монокристаллов на рентгеновском спектрометре* // *ПТЭ*. 1985. № 5. С. 173-175.

УДК. 541.1+681.2

ВИБІР ОПТИМАЛЬНИХ РОЗМІРІВ ПОСУДИНИ З РІДИНОЮ ПРИ ВИМІРЮВАННІ ПОВЕРХНЕВОГО НАТЯГУ РІДИН МЕТОДОМ ВИТЯГУВАННЯ КІЛЬЦЯ

© Витвицька Л.А., 1998

Івано-Франківський державний технічний університет нафти і газу

На основі математичного моделювання складного рідинно-газово-го мостика, утвореного між кільцем, розташованим на поверхні рідини, та стінкою посудини, в якій ця рідина знаходитьться, отримано залежності для розрахунку оптимальних розмірів посудини при визначенні поверхневого натягу методом кільця.

Вимірювання поверхневого натягу методом витягування кільця полягає у визначенні натягу рідини за вимірюними значеннями сили, прикладеної до горизонтально підвішеного кільця при його витягуванні з досліджуваної рідини, та висоти підняття кільця відносно рівня незбуреної поверхні рідини [1]. У теоретичних викладках, що стосуються даного методу і описані в [1-3], вважається, що поверхня досліджуваної рідини не має обмежень у розмірах. Однак у реальних умовах рідина знаходиться в посудині певних розмірів. Так, у приладі, який реалізує вищевказаний метод [2], циліндрична посудина з досліджуваною рідиною розміщується на підйомному столику, який рухається вгору-вниз за допомогою крокового двигуна. Стінки посудини з рідиною впливають на значення сили, прикладеної до кільця. Цей вплив,

який називають «пристінним ефектом», зумовлений взаємодією між собою двох менісків, утворених наявністю кільця і стінки посудини. Оскільки місткість посудини є постійною, то при достатній близькості один від одного ці два меніски, накладаючись, змінюють положення рівня незбуреної рідини, відносно якого ведеться відлік об'єму піднятої рідини, що і впливає на значення прикладеної сили (рис.1). Тому сила F , яка необхідна для витягування кільця з рідини, є функцією не тільки розмірів кільця (R, r), кута змочування його поверхні (θ) і значення поверхневого натягу (σ), але й радіуса посудини циліндричної форми ($R_{пос}$) та кута змочування рідини її стінки (θ_c).